

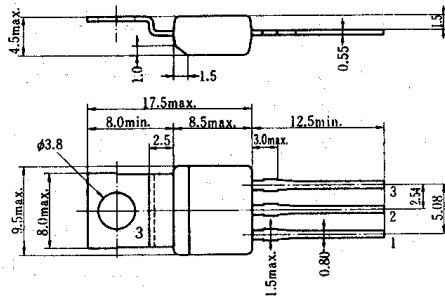
# 2SC2278

シリコン NPN 三重拡散形

高周波高電圧増幅用  
TV 映像出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER  
TV VIDEO OUTPUT



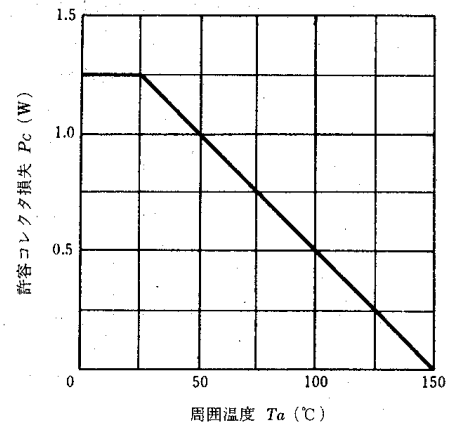
1. エミッタ: Emitter
  2. ベース: Base
  3. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-202AA MOD.)

## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SC2278	Unit
コレクタ・ベース電圧		$V_{CB0}$	300	V
コレクタ・エミッタ電圧		$V_{CE0}$	300	V
エミッタ・ベース電圧		$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流		$I_C$	100	mA
ベース電流		$I_B$	50	mA
許容コレクタ損失		$P_C$	1.25	W
接合部温度		$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		$T_{stg}$	-45~+150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流		$I_{CEO}$	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=20\text{mA}, I_B=2\text{mA}$	—	—	1.5	V
直流電流増幅率		$h_{FE}$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=20\text{mA}$	30	—	200	
利得帯域幅積		$f_T$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=20\text{mA}$	50	80	—	MHz
逆伝達容量		$C_{re}^*$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}, \text{Emitter ground}$	—	2	3	pF

\*エミッタ端子はアースに接続する。

\*Emitter lead is grounded.